



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2011-0057263
(43) 공개일자 2011년05월31일

(51) Int. Cl.

H01L 25/075 (2006.01) H01L 27/15 (2006.01)

(21) 출원번호 10-2011-7009227

(22) 출원일자(국제출원일자) 2009년08월25일

심사청구일자 없음

(85) 번역문제출일자 2011년04월22일

(86) 국제출원번호 PCT/DE2009/001217

(87) 국제공개번호 WO 2010/034278

국제공개일자 2010년04월01일

(30) 우선권주장

10 2008 049 188.8 2008년09월26일 독일(DE)

(71) 출원인

오스람 옵토 세미컨덕터스 게엠베하

독일 레겐스부르크 라이브니츠슈트라쎄 4 (우:93055)

(72) 발명자

브라우너, 버트

독일, 93173 웬젠바츠, 리리엔스트라쎄 19

소르그, 조르그 에리츠

독일, 93053 레겐스부르크, 고즈라트스트라쎄 12 (뒷면에 계속)

(74) 대리인

허용특

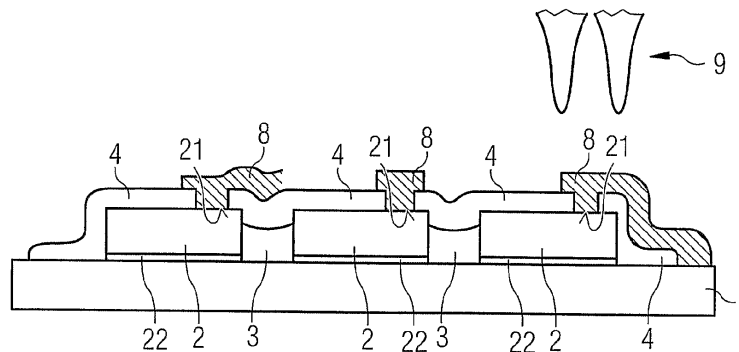
전체 청구항 수 : 총 15 항

(54) 캐리어 기판 및 복수 개의 복사 방출 반도체 소자를 포함한 광전 모듈 및 그 제조 방법

(57) 요약

광전 모듈이 제공되고, 상기 광전 모듈은 캐리어 기판(1) 및 복수 개의 복사 방출 반도체 소자들(2)을 포함한다. 캐리어 기판(1)은 구조화된 도전로들을 포함한다. 복사 방출 반도체 소자들(2)은 각각 전자기 복사의 생성에 적합한 활성층(2a), 제1접촉면(21) 및 제2접촉면(22)을 포함하고, 이때 상기 제1접촉면(21)은 각각 상기 캐리어 기판(1)과 반대 방향을 향해 있는 복사 방출 반도체 소자들(2)의 측에 배치된다. 복사 방출 반도체 소자들(2)은 전기 절연층(4)을 구비하고, 상기 전기 절연층은 각각 상기 제1접촉면(21)의 영역에서 리세스를 포함한다. 전기 절연층(4)상에 국부적으로 도전 구조체들(8)이 배치된다. 도전 구조체들(8) 중 하나는 적어도, 복사 방출 반도체 소자(2)의 제1접촉면(21)을 다른 복사 방출 반도체 소자(2)의 다른 제1접촉면(21)과 전기 전도적으로 연결하거나, 상기 캐리어 기판(1)의 도전로와 전기 전도적으로 연결한다. 또한, 이러한 모듈의 제조 방법이 제공된다.

대표도 - 도2



(72) 발명자

와이드너, 칼

독일, 81245 뮌헨, 자우서웨그 6

웨그레이터, 월터

독일, 93152 니텐도르프, 마리엔스트라쎄 15

우츠, 올리버

독일, 93049 레겐스부르크, 로터 브라츠웨그 16

특허청구의 범위

청구항 1

캐리어 기관(1) 및 복수 개의 복사 방출 반도체 소자들(2)을 포함하는 광전 모듈에 있어서,
 상기 캐리어 기관(1)은 상기 복사 방출 반도체 소자들(2)의 전기 접촉을 위해 구조화된 도전로들을 포함하고,
 상기 복사 방출 반도체 소자들(2)은 각각 전자기 복사의 생성을 위해 적합한 활성층(2a), 제1접촉면(21) 및 제2 접촉면(22)을 포함하고, 이때 상기 제1접촉면(21)은 각각 상기 캐리어 기관(1)과 반대 방향을 향해 있는 복사 방출 반도체 소자들(2)의 측에 배치되고,
 상기 복사 방출 반도체 소자들(2)은 전기 절연층(4)을 구비하며, 상기 전기 절연층은 각각 상기 복사 방출 반도체 소자들(2)의 제1접촉면(21)의 영역에서 리세스를 가지며,
 상기 전기 절연층(4)상에 국부적으로 도전 구조체들(8)이 배치되고, 그리고
 상기 도전 구조체들 중 하나는 적어도, 복사 방출 반도체 소자(2)의 제1접촉면(21)을 다른 복사 방출 반도체 소자(2)의 다른 제1접촉면과 전기 전도적으로 연결하거나, 상기 캐리어 기관(1)의 도전로와 전기 전도적으로 연결 하는 것을 특징으로 하는 광전 모듈.

청구항 2

청구항 1에 있어서,
 상기 복사 방출 반도체 소자들(2) 사이에 평탄화층(3)이 적어도 배치되는 것을 특징으로 하는 광전 모듈.

청구항 3

청구항 2에 있어서,
 상기 평탄화층(3)은 적어도 하나의 변형 부재를 포함하는 것을 특징으로 하는 광전 모듈.

청구항 4

청구항 1 내지 청구항 3 중 어느 한 항에 있어서,
 상기 전기 절연층(4)은 적어도 하나의 변형 부재(6)를 포함하는 것을 특징으로 하는 광전 모듈.

청구항 5

청구항 1 내지 청구항 4 중 어느 한 항에 있어서,
 상기 복사 방출 반도체 소자들(2)은 공통적으로, 상기 캐리어 기관(1)상에 배치된 프레임(7)에 의해 둘러싸이는 것을 특징으로 하는 광전 모듈.

청구항 6

청구항 1 내지 청구항 5 중 어느 한 항에 있어서,
 상기 캐리어 기관(1)은 연성 기관인 것을 특징으로 하는 광전 모듈.

청구항 7

청구항 1 내지 청구항 6 중 어느 한 항에 있어서,
 상기 캐리어 기관(1)에서 상기 복사 방출 반도체 소자들(2)이 배치된 표면은 평활하지 않은 것을 특징으로 하는 광전 모듈.

청구항 8

청구항 1 내지 청구항 7 중 어느 한 항에 있어서,

상기 도전 구조체들(8)은 이방성층으로 형성되고, 상기 이방성층은 상기 전기 절연층(4)상에 배치되며, 각각의 복사 방출 반도체 소자들(2)의 제1접촉면(21)의 영역에서 전기 전도 영역들(8a)을 적어도 포함하는 것을 특징으로 하는 광전 모듈.

청구항 9

청구항 1 내지 청구항 7 중 어느 한 항에 있어서,

상기 전기 절연층(4)은 구조화된 도체판 및 상기 도전 구조체들(8)에 의해, 상기 도체판으로부터 돌출한 전기 전도 웹을 이용하여 형성되는 것을 특징으로 하는 모듈.

청구항 10

청구항 1 내지 청구항 9 중 어느 한 항에 있어서,

상기 전기 절연층(4)은 국부적으로 각각의 복사 방출 반도체 소자(2)의 측면에서 각각의 복사 방출 반도체 소자(2)의 둘레에 이어지고, 각각의 복사 방출 반도체 소자(2)의 제1접촉면(21)은 상기 전기 절연층(4)상에 배치되어, 상기 캐리어 기관(1)과 반대 방향을 향해 있는 복사 방출 반도체 소자들(2)의 표면은 상기 제1접촉면(21)을 포함하지 않는 것을 특징으로 하는 모듈.

청구항 11

광전 모듈의 제조 방법에 있어서,

캐리어 기관(1)상에 복수 개의 복사 방출 반도체 소자들(2)을 배치하는 단계로, 이때 상기 캐리어 기관(1)은 상기 복사 방출 반도체 소자들(2)의 전기 접촉을 위해 구조화된 도전로들을 포함하고, 상기 복사 방출 반도체 소자들(2)은 각각 전자기 복사의 생성을 위해 적합한 활성층(2a), 제1접촉면(21) 및 제2접촉면(22)을 포함하며, 이때 상기 제1접촉면(21)은 각각 상기 캐리어 기관(1)과 반대 방향을 향해 있는 상기 복사 방출 반도체 소자들(2)의 측에 배치되도록 하는 단계,

상기 복사 방출 반도체 소자들(2)상에 전기 절연층(4)을 적층하는 단계로, 이때 상기 전기 절연층(4)은 각각의 복사 방출 반도체 소자(2)의 제1접촉면(21)의 영역에서 리세스(4a)를 각각 포함하도록 하는 단계,

상기 전기 절연층(4)의 일부 영역들상에 도전 구조체들(8)을 적층하는 단계로, 이때 상기 도전 구조체들(8) 중 하나는 적어도, 복사 방출 반도체 소자(2)의 제1접촉면(21)을 다른 복사 방출 반도체 소자(2)의 다른 제1접촉면(21)과 전기 전도적으로 연결하거나, 상기 캐리어 기관(1)의 도전로와 전기 전도적으로 연결하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 광전 모듈의 제조 방법.

청구항 12

청구항 11에 있어서,

상기 도전 구조체들(8)은 인쇄 방법을 이용하여 적층되는 것을 특징으로 하는 광전 모듈의 제조 방법.

청구항 13

청구항 11에 있어서,

상기 도전 구조체들(8)은 기상 증착을 이용하여 적층되는 것을 특징으로 하는 광전 모듈의 제조 방법.

청구항 14

청구항 11에 있어서,

상기 도전 구조체들(8)은 이방성층을 이용하여 형성되고, 상기 이방성층은 상기 전기 절연층(4)상에 배치되며, 각각의 복사 방출 반도체 소자들(2)의 제1접촉면(21)의 영역에서 전기 전도적으로 적어도 형성되는 것을 특징으로 하는 광전 모듈의 제조 방법.

청구항 15

청구항 11에 있어서,

상기 도전 구조체들(8)은 각각 전기 전도 웹으로서 형성되고, 이때 상기 웹은 각각 스탬핑-웨이 공정을 이용하여 복사 방출 반도체 소자(2)의 제1접촉면(21)과 전기 전도적으로 연결되는 것을 특징으로 하는 광전 모듈의 제조 방법.

명세서

기술 분야

[0001] 본 특허 출원은 독일 특허 출원 10 2008 049188.8의 우선권을 청구하고, 그 공개 내용은 참조로 포함된다.

[0002] 본 발명은 캐리어 기관 및 복수 개의 복사 방출 반도체 소자들을 포함한 광전 모듈에 관한 것이다. 또한, 본 발명은 광전 모듈의 제조 방법에 관한 것이기도 하다.

배경 기술

[0003] 종래의 광전 모듈의 경우 칩과 캐리어 사이의 전기 접촉 기술로서 주로 와이어본딩, 납땜 또는 도전 접착제를 이용한 칩 실장이 사용되어 왔다. 이러한 방식으로, 예를 들면 조명 모듈을 위한 LED 어레이가 생성된다. 초소형 추세에 따라 항상 더 작은 치수의 모듈, 예를 들면 모듈 높이 및/또는 모듈의 밑면에 있어 더 작은 치수가 필요하다.

[0004] LED를 위한 초소형 구조 및 결합 기술은 공개 문헌 DE 10 353 679 A1에 공지되어 있다. 이때의 소자는 캐리어 및 그 위에 배치된 반도체칩을 포함하고, 상기 반도체칩은 평면으로 접촉되어 있다.

[0005] 평면 접촉된 반도체칩을 포함하는 모듈은 소자의 높이가 작다는 이점이 있어서, 바람직하게는 반도체칩의 광 출사면과 기존의 광학 소자들 사이의 간격이 최소로 얻어질 수 있다. 그러나, 평면 접촉에 의해 모듈의 밑면이 즉각적으로 감소하진 않는데, 반도체칩의 전기 접촉을 위해 역할하며 캐리어상에 배치되는 도전 구조체들은 전기 절연 상태로 모듈안에 통합되어야 하기 때문이다.

[0006] 특히, 복수 개의 복사 방출 반도체 소자들을 포함하는 모듈의 경우 캐리어 기관상에 광전 소자들이 콤팩트하게 배치되는 것이 필요하다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0007] 본 발명의 과제는 광전 모듈을 제공하되 특히 설계 높이가 작으면서도 그와 동시에 복수 개의 복사 방출 반도체 소자들이 콤팩트하게 배치되어 있는 광전 모듈을 제공하는 것이다.

과제의 해결 수단

[0008] 이러한 과제는 특허청구범위 제1항의 특징을 포함한 광전 모듈 및 특허청구범위 제11항의 특징을 포함한 그 제조 방법에 의하여 해결된다. 모듈 및 방법에 대한 유리한 실시예 및 바람직한 발전에는 종속항들의 주체이다.

[0009] 본 발명에 따르면, 캐리어 기관 및 복수 개의 복사 방출 반도체 소자들을 포함한 광전 모듈이 제공된다. 캐리어 기관은 복사 방출 반도체 소자들의 전기 접촉을 위해 구조화된 도전로들을 포함한다. 복사 방출 반도체 소자들은 각각 전자기 복사의 생성을 위해 적합한 활성층, 제1접촉면 및 제2접촉면을 포함하고, 이때 제1접촉면은 각각 캐리어 기관과 반대 방향을 향해 있는 복사 방출 반도체 소자들의 측에 배치된다. 복사 방출 반도체 소자들은 전기 절연층을 구비하고, 전기 절연층은 각각 복사 방출 반도체 소자의 제1접촉면의 영역에서 리세스(recess)를 포함한다. 전기 절연층상에 국부적으로 도전 구조체들이 배치된다. 도전 구조체들 중 하나는 적어도, 복사 방출 반도체 소자의 제1접촉면을 다른 복사 방출 반도체 소자의 다른 제1접촉면과 전기 전도적으로 연결하거나, 캐리어 기관의 도전로와 전기 전도적으로 연결한다.

[0010] 복사 방출 반도체 소자의 전기 접촉은 캐리어 기관과 이격되어 안내되는 와이어에 의해 이루어지지 않고, 적어도 부분적으로 전기 절연층상에 안내되는 도전 구조체에 의해 이루어진다. 이러한 방식의 전기 접촉에 의해 매우 낮은 설계 높이를 가진 모듈이 얻어져서 유리하다. 또한, 복사 방출 반도체 소자들을 상호간에 전기 전도적으로 연결하거나 캐리어 기관의 도전로와 전기 전도적으로 연결하는 도전 구조체에 의해 콤팩트한 모듈이 제공될 수 있다. 그러므로, 모듈의 복사 방출 반도체 소자들은 공간 절약적 방식으로 캐리어 기관상에 배치될 수

있다. 모듈의 밀면도 축소한다는 이점이 있다.

- [0011] 또한, 도전 구조체가 복사 방출 반도체 소자들에 근접하여 배치될 수 있다. 이러한 방식의 복사 방출 반도체 소자들 접촉에 의해, 매우 낮은 설계 높이를 가진 모듈이 얻어지고, 이러한 설계 높이에 의해 특히 예를 들면 광학 부재들이 복사 방출 반도체 소자들에 근접하여 배치될 수 있으므로 유리하다.
- [0012] 광학 부재들이란 예를 들면 렌즈를 의미할 수 있다. 특히, 광학 부재들이란 반도체 소자로부터 방출된 복사에 대해 목적인 바에 따라 영향을 미치고, 특히 방출 특성을 변경하는 부재들을 의미한다.
- [0013] 복사 방출 반도체 소자는 바람직하게는 반도체칩, 더욱 바람직하게는 광 방출 다이오드(LED)이다.
- [0014] 복사 방출 반도체 소자는 각각 활성층을 포함한다. 활성층은 복사 생성을 위해 각각 pn 접합, 이중이종구조, 단일양자우물구조(SQW, single quantum well) 또는 다중양자우물구조(MQW, multi quantum well)를 포함한다. 양자우물구조란 명칭은 양자화의 차원성에 대한 의미를 전개하진 않는다. 상기 명칭은 특히 양자상자, 양자선, 양자점 및 이들 구조들의 각 조합을 포괄한다.
- [0015] 바람직하게는, 복사 방출 반도체 소자들은 각각 질화물-, 인화물- 또는 비화물 화합물 반도체계이다. 이와 관련하여 "질화물-, 인화물- 또는 비화물 화합물 반도체계"란, 활성 에피택시층 시퀀스 또는 그 중 적어도 하나의 층이 각각 $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$, $x+y \leq 1$ 일 때 $\text{In}_x\text{Ga}_y\text{Al}_{1-x-y}\text{P}$, $\text{In}_x\text{Ga}_y\text{Al}_{1-x-y}\text{N}$ 또는 $\text{In}_x\text{Ga}_y\text{Al}_{1-x-y}\text{As}$ 라는 조성을 가지는 III/V 반도체 물질을 포함한다는 것을 의미한다.
- [0016] 바람직한 형성예에서, 복사 방출 반도체 소자는 각각 박막 반도체 소자로서 형성된다. 본 출원의 틀에서 박막 반도체 소자란, 상기 소자의 제조 동안에 반도체층 시퀀스가 예를 들면 에피택시얼 방식으로 성장되었던 성장 기관이 분리되어 있는 반도체 소자를 가리킨다. 이때 상기 반도체층 시퀀스는 박막 반도체 소자의 반도체 몸체를 포함한다. 복사 방출 반도체 소자는 각각 캐리어 기관과 결합되고, 상기 캐리어 기관은 반도체 소자의 반도체층 시퀀스를 위한 성장 기관과는 상이하다.
- [0017] 캐리어 기관은 가령 결정 구조와 관련하여 성장 기관이 충족해야 하는 것과 같은 요건이 비교적 까다롭지 않아 유리하다. 성장 기관의 물질을 선택할 때보다 캐리어 기관의 물질을 선택할 때 더 많은 물질이 가능하다.
- [0018] 바람직하게는, 전기 절연층은 복사 방출 반도체 소자의 활성층으로부터 방출된 복사에 대하여 적어도 부분적으로 복사 투과성이다. 복사 방출 반도체 소자들로부터 방출된 복사는 전기 절연층을 통해 아웃커플링될 수 있고, 이때 현저한 광학적 손실은 없다. 유리하게도, 활성층으로부터 방출된 복사가 전기 절연층에서 흡수되는 경우가 줄어들 수 있어서, 모듈의 효율이 증가한다는 이점이 있다. 바람직하게는, 활성층으로부터 방출된 복사 방출 반도체 소자의 복사가 전기 절연층에서 흡수되는 것은 40%미만, 더욱 바람직하게는 20% 미만이다.
- [0019] 바람직하게는, 전기 절연층은 필름, 래커 또는 폴리머층이다.
- [0020] 바람직한 형성예에서, 전기 절연층은 적어도 하나의 변환 부재를 포함한다. 가령 YAG:Ce 분말과 같은 적합한 변환 부재는 예를 들면 WO 98/12757 에 기술되어 있고, 그 내용은 참조로 포함된다.
- [0021] 바람직하게는, 복사 방출 반도체 소자들은 각각 파장(λ_0)을 가진 1차 복사를 방출한다. 바람직하게는, 전기 절연층의 변환 부재는 파장(λ_0)의 복사를 적어도 부분적으로 흡수하고, 다른 파장 영역에서 2차 복사를 방출한다. 이를 통해 모듈은 혼합 복사를 방출하며, 상기 혼합 복사는 복사 방출 반도체 소자의 1차 복사 및 변환 부재의 2차 복사를 포함한다.
- [0022] 변환 부재를 목적에 따라 선택함으로써, 복사 방출 반도체 소자로부터 방출도니 복사의 색 위치가 변경될 수 있다. 이를 통해, 유리하게도, 모듈로부터 방출된 복사의 원하는 색 위치가 달성될 수 있다.
- [0023] 이하에서 색 위치란, CIE 색 공간에서 모듈의 방출된 광의 색을 나타내는 수치값을 의미한다.
- [0024] 또는, 전기 절연층은 2개 이상의 변환 부재를 포함할 수 있다. 이를 통해, 모듈로부터 방출된 복사는 혼합 복사로 얻어지는데, 상기 혼합 복사는 1차 복사 및 복수 개의 변환 부재들의 복수 개의 2차 복사를 포함한다. 2개 이상의 변환 부재를 사용함으로써, 색 위치의 색 선택이 정확해진다는 이점이 있어, 모듈의 방출된 복사의 색 위치가 원하는 대로 얻어진다.
- [0025] 덧붙여 말하자면, 복사 방출 반도체 소자가 각각 동일한 파장 영역에서 1차 복사를 반드시 방출할 필요는 없다. 오히려, 복사 방출 반도체 소자는, 상기 소자가 적어도 부분적으로 서로 다른 파장 영역에서 복사를 방출하도록 형성될 수 있다. 반도체 소자들로부터 방출된 복사가 겹침으로써, 모듈로부터 방출된 혼합 복사가 발생할 수

있고, 이러한 혼합 복사는 CIE 색 공간의 백색의 색 영역에 위치하는 것이 바람직하다.

- [0026] 바람직한 형성에에서, 개별 복사 방출 반도체 소자들 사이에는 평탄화층이 적어도 배치된다.
- [0027] 평탄화층에 의해, 캐리어 기관과 반대 방향인 모듈의 표면이 평활하게 얻어질 수 있어 유리하다. 바람직하게는, 전기 절연층은 이러한 평활한 표면상에 배치된다. 더욱 바람직하게는, 평탄화층은 전기 절연성이다.
- [0028] 모듈의 일 형성에에서, 평탄화층은 적어도 하나의 변환 부재를 포함한다. 더욱 바람직하게는, 변환 부재는 복사 방출 반도체 소자들 중 적어도 하나로부터 방출된 복사를 흡수하고, 이러한 복사를 다른 파장의 복사로 변환하여, 모듈로부터 방출된 복사가 혼합 복사로서 생성된다.
- [0029] 변환 부재 또는 변환 부재들이 전기 절연층 및/또는 평탄화층에 직접적으로 통합됨으로써, 유리하게는 다른 광학층들이 필요하지 않다. 광학층들은 특히, 복사 방출 반도체 소자들로부터 방출된 복사의 색 위치를 목적에 맞게 변경하거나/변경하고 보정하는 층들이다. 변환 부재가 전기 절연층 및/또는 평탄화층에 통합되고, 복사 방출 반도체 소자가 바람직하게는 평탄화층 및/또는 전기 절연층에 의해 직접적으로 둘러싸임으로써, 유리하게는 복사 방출 반도체 소자로부터 방출된 복사가 복사 방출 반도체 소자에서 거의 변환된다. 이를 통해 유리하게도 콤팩트한 모듈이 가능하다.
- [0030] 이 경우, 전기 절연층은 광 변환층의 기능, 도전 구조체를 위한 캐리어층의 기능 및 복사 방출 소자를 위한 보호층의 기능을 가질 수 있다.
- [0031] 바람직한 모듈의 형성에에서, 복사 방출 반도체 소자들은 캐리어 기관상에 배치된 프레임에 의해 함께 둘러싸인다.
- [0032] 바람직하게는, 프레임은 세라믹 또는 플라스틱을 포함한다. 프레임을 이용하면, 복사 방출 반도체 소자는 주변 매질로부터 공간적으로 분리된다. 또한, 프레임은 복사 방출 반도체 소자를 예를 들면 환경 영향으로부터 보호하여 유리하다. 환경 영향은 예를 들면 충격 또는 침습이 있다.
- [0033] 모듈의 바람직한 형성에에서, 캐리어 기관은 연성 기관이다.
- [0034] 따라서, 캐리어 기관이 반드시 경성으로 형성될 필요는 없다. 특히, 캐리어 기관은 필름으로 형성될 수 있다.
- [0035] 모듈의 바람직한 형성에에서, 캐리어 기관에서 복사 방출 반도체 소자가 배치된 표면은 평활하지 않다.
- [0036] 캐리어 기관은 예를 들면 아치 곡면을 포함할 수 있다. 특히, 복사 방출 반도체 소자가 캐리어 기관의 표면 중 하나에 실장될 수 있는 경우에 한하여, 캐리어 기관의 표면은 다른 형상을 가질 수 있다.
- [0037] 모듈의 바람직한 형성에에서, 도전 구조체들은 이방성 층으로 형성되고, 상기 이방성층은 전기 절연층상에 배치되며, 각각의 복사 방출 반도체 소자의 제1접촉면의 영역에서 전기 전도 영역들을 적어도 포함한다.
- [0038] 이방성 필름은 부분적으로, 도전 영역들을 포함한다. 전도도는 예를 들면 국부적으로 인가된 압력 또는 조사에 의해 발생할 수 있다. 이방성 필름의 도전 영역들에 의해, 각각 복사 방출 반도체 소자의 전기적 연결이 보장된다.
- [0039] 바람직하게는, 이방성 필름은 적어도 부분적으로, 반도체 소자로부터 방출된 복사에 대하여 복사 투과성이다. 특히, 이방성 필름은, 더욱 바람직하게는 반도체 소자로부터 방출된 복사에 대해 일부 영역들에서 적어도 부분적으로 복사 투과성이며, 이러한 영역은 전도도가 없다.
- [0040] 또는, 이방성 필름은 국부적으로 제거될 수 있다. 특히, 이 경우, 이방성 필름은 바람직하게는 복사 방출 반도체 소자의 복사 출사측의 영역에서 제거된다.
- [0041] 모듈의 바람직한 형성에에서, 전기 절연층은 구조화된 도체판 및 도전 구조체들에 의해, 상기 도체판으로부터 돌출한 전기 전도 웹(web)을 이용하여 형성된다.
- [0042] 바람직하게는, 웹들은 각각 도체판의 도전로의 접촉 지점으로부터 복사 방출 반도체 소자의 제1접촉면까지 이어진다. 이때, 바람직하게는, 웹은 각각, 상기 웹이 상기 도체판으로부터 멀어지면서 반도체 소자의 방향으로 가며 굴곡지도록 형성된다. 바람직하게는, 도체판은 리세스를 포함하고, 더욱 바람직하게는 상기 리세스는 각각 복사 방출 반도체 소자의 제1접촉면 상부에 배치된다. 바람직하게는, 웹은 금속웹이다.
- [0043] 바람직하게는, 도체판은 도전로들을 포함한다. 도체판의 도전로는 각각 바람직하게는 전기적으로 서로 절연되

어 배치된다. 더욱 바람직하게는, 이러한 전기적 절연은 리세스에 의해 이루어지며, 상기 리세스는 도체판의 도전로들사이의 간격을 이룬다.

- [0044] 모듈의 이러한 형성에에서, 복수 개의 도체판들은 포개어져 배치될 수 있어서, 다결의 배열이 형성된다. 이를 통해, 유리하게는 모듈의 복수 개의 회로면이 가능하고, 따라서 모듈에서 회로 집적도가 더 높게 달성되어 유리하다.
- [0045] 모듈의 또 다른 바람직한 형성에에서, 전기 절연층은 각각 국부적으로, 각 복사 방출 반도체 소자의 측면에서 각각의 복사 방출 반도체 소자의 둘레에 이어진다. 각각, 복사 방출 반도체 소자의 제1접촉면은 전기 절연층상에서 이어짐으로써, 각각 캐리어 기관과 반대 방향을 향해 있는 복사 방출 반도체 소자의 표면은 제1접촉면을 포함하지 않는다.
- [0046] 제1접촉층이 이와 같이 이어짐으로써, 복사 방출 반도체 소자의 전원 공급이 균일하게 보장된다. 또한, 제1접촉층의 임의의 영역들에 복사 방출 반도체 소자의 외부 전기 연결부가 배치될 수 있다.
- [0047] 바람직하게는, 전기 절연층은 반도체 소자의 측면에서 반도체 소자의 활성층을 경유한다.
- [0048] 이와 같이 이어지는 반도체 소자의 제1접촉면에 의해, 반도체 소자의 전기적 연결 또는 반도체 소자들간의 복합 회로 형성이 가능하다. 이를 통해, 캐리어 기관상에 반도체 소자들이 공간 절약적으로 배치될 수 있어 유리하다.
- [0049] 본 발명에 따른 광전 모듈의 제조 방법은 특히 이하의 단계를 포함한다:
- [0050] a) 캐리어기관상에 복수 개의 복사 방출 반도체 소자들을 배치하되, 이때 캐리어 기관은 복사 방출 반도체 소자의 전기 접촉을 위해 구조화된 도전로들을 포함하며, 상기 복사 방출 반도체 소자들은 각각 전자기 복사의 생성을 위해 적합한 활성층, 제1접촉면 및 제2접촉면을 포함하고, 이때 각각 제1접촉면은 복사 방출 반도체 소자에서 상기 캐리어 기관과 반대 방향을 향하는 측에 배치되도록 하는 단계;
- [0051] b) 복사 방출 반도체 소자상에 전기 절연층을 적층되는 단계로, 이때 전기 절연층은 각각의 복사 방출 반도체 소자의 제1접촉면의 영역에서 각각 리세스를 포함하도록 하는 단계, 그리고
- [0052] c) 상기 전기 절연층의 부분 영역들상에 도전 구조체들이 적층되는 단계로, 이때 도전 구조체들 중 하나는 적어도, 복사 방출 반도체 소자의 제1접촉면을 다른 복사 방출 반도체 소자의 다른 제1접촉면과 전기 전도적으로 연결하거나, 캐리어 기관의 도전로와 전기 전도적으로 연결하는 단계.
- [0053] 방법의 유리한 형성에는 모듈의 유리한 형성과 유사하게 얻어지며, 그 반대의 경우도 그러하다.
- [0054] 반도체 소자가 평면 도전 구조체들에 의해 전기 접촉됨으로써, 유리하게도 모듈의 높이가 최소화된다. 이와 동시에, 유리하게는 모듈의 밑면이 비교적 종래의 모듈보다 작아진다.
- [0055] 전기 절연층이 사용되고, 상기 전기 절연층상에 반도체 소자의 전기 접촉을 위한 도전 구조체들이 안내됨으로써, 유리하게도 모듈의 설계 공정이 간단해진다. 유리하게는, 반도체 소자의 회로, 반도체 소자의 봉지 및 경우에 따라서 광 변환이 각각 코팅 공정을 이용하여 이루어진다. 상기 광 변환은 바람직하게는 전기 절연층에 통합된 변환 부재에 의해 이루어진다.
- [0056] 방법의 바람직한 형성에에서, 도전 구조체들은 압력 방법을 이용하여 적층된다.
- [0057] 바람직하게는, 도전 구조체들은 스크린 인쇄 방법, 스텐실 인쇄(stencil printing) 방법 또는 패드 인쇄 방법을 이용하여 전기 절연층상에 적층된다.
- [0058] 또는, 도전 구조체들은 기상 증착을 이용하여 적층될 수 있다.
- [0059] 이때, 도전 구조체들은 물리 기상 증착(PVD 공정) 또는 화학 기상 증착(CVD 공정)을 이용하여 적층될 수 있다.
- [0060] 더욱 바람직하게는, 도전 구조체들은 국부적으로 적층된다. 바람직하게는, 인쇄, 분사 또는 마스크 기술과 연계된, 특히 스텐실과 연계된 PVD/CVD를 이용하여 도전 구조체들이 선택적으로 적층된다.
- [0061] 도전 구조체들의 적층을 위한 다른 가능성은 전기 절연층상에 도전로들이 직접 인쇄되는 것이다.
- [0062] 다른 바람직한 형성에에서, 도전 구조체들은 이방성층을 이용하여 형성되고, 상기 이방성층은 전기 절연층상에 배치되고, 각각의 복사 방출 반도체 소자의 제1접촉면의 영역에서 전기 전도적으로 적어도 형성된다.

- [0063] 바람직하게는, 이방성층의 전기 전도 영역들이 형성되는 것은 인쇄 방법, 온도 방법, 또는 예를 들면 UV 레이저를 이용한 조사 방법을 이용한다.
- [0064] 또는, 도전 구조체들은 필름안에 통합될 수 있고, 상기 필름은 전기 절연 필름상에 라미네이팅된다. 이 경우, 라미네이팅된 필름은 도전 구조체들, 예를 들면 금속배선을 포함한다. 이러한 도전 구조체들은 바람직하게는 이미 필름안에 배치되어, 복사 방출 반도체 소자의 전기 접촉이 소정의 방식으로 가능하다. 더욱 바람직하게는, 자동화된 접촉 방법이 사용될 수 있다(TAB 방법: tape automated bonding).
- [0065] 방법의 바람직한 형성예에서, 전기 절연층의 적층 이전에 평탄화층이 적어도, 복사 방출 반도체 소자들 사이의 간극에 삽입된다. 이러한 방식으로, 모듈이 평탄화되어, 캐리어 기관과 반대 방향을 향해 있는 모듈의 표면이 평활하게 형성된다.
- [0066] 방법의 다른 바람직한 형성예에서, 도전 구조체들은 각각 전기 전도 웹으로서 형성되고, 이때 상기 웹은 각각 스탬핑 웨지(stamping wedge) 공정을 이용하여 복사 방출 반도체 소자의 제1접촉면과 전기 전도적으로 연결된다.
- [0067] 광전 모듈 및 그 제조 방법의 다른 특징, 이점, 바람직한 형성에 및 합목적성은 이하에서 도 1 내지 도 9와 관련하여 설명한 실시예로부터 도출된다.

도면의 간단한 설명

- [0068] 도 1은 제조 방법의 중간 단계에서 모듈의 제1실시예에 대한 개략적 횡단면도를 도시한다.
- 도 2는 본 발명에 따른 모듈의 다른 실시예에 대한 개략적 횡단면도를 도시한다.
- 도 3은 본 발명에 따른 모듈의 실시예에 대한 개략적 횡단면도를 도시한다.
- 도 4는 본 발명에 따른 모듈의 다른 실시예에 대한 개략적 부분도를 도시한다.
- 도 5는 본 발명에 따른 모듈의 다른 실시예에 대한 개략적 부분도를 도시한다.
- 도 6은 본 발명에 따른 모듈의 다른 실시예에 대한 개략적 횡단면도를 도시한다.
- 도 7a는 본 발명에 따른 모듈의 다른 실시예에 대한 개략적 부분도를 도시한다.
- 도 7b는 도 7a의 실시예의 일부분에 대한 개략적 평면도를 도시한다.
- 도 7c는 본 발명에 따른 모듈의 다른 실시예에 대한 개략적 평면도를 도시한다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0069] 동일하거나 동일한 기능의 구성요소는 각각 동일한 참조번호를 가진다. 도시된 구성요소들 및 그 구성요소들간의 크기비는 정확한 치수로 볼 수 없다.
- [0070] 도 1에는 광전 모듈이 도시되어 있고, 광전 모듈은 캐리어 기관(1) 및 복수 개의 복사 방출 반도체 소자들(2)을 포함한다. 복사 방출 반도체 소자들(2)은 각각 전자기 복사의 생성을 위한 활성층, 제1접촉면(21) 및 제2접촉면(22)을 포함한다. 제1접촉면(21)은 캐리어 기관(1)과 반대 방향을 향해 있는 복사 방출 반도체 소자(2)의 표면에 배치된다.
- [0071] 복사 방출 반도체 소자(2)는 바람직하게는 반도체칩으로서 형성되고, 더욱 바람직하게는 각각 광 방출 다이오드(LED)로서 형성된다.
- [0072] 복사 방출 반도체 소자(2)의 활성층은 각각 복사 생성을 위해 각각 pn 접합, 이중이종구조, 단일양자우물구조 또는 다중양자우물구조를 포함한다. 바람직하게는, 복사 방출 반도체 소자(2)는 각각 질화물-, 인화물 - 또는 비화물 화합물 반도체계이다.
- [0073] 캐리어 기관(1)은 복사 방출 반도체 소자(2)의 전기 접촉을 위해 구조화된 도전로들을 포함한다. 특히, 바람직하게는, 각각 하나의 복사 방출 반도체 소자(2)가 캐리어 기관(1)의 도전로상에 배치된다. 이는, 각각 제2접촉면(22)이 캐리어 기관(1)의 도전로와 기계적 및 전기적으로 접촉하고 있음을 의미한다.
- [0074] 바람직하게는, 각각 하나의 복사 방출 반도체 소자(2)가 배치된 도전로들은 전기적으로 서로 절연된다. 복사 방출 반도체 소자(2)는 캐리어 기관(1)의 도전로들상에 전기적으로 서로 절연되어 배치된다.

- [0075] 바람직하게는, 개별 복사 방출 반도체 소자들(2) 사이에 평탄화층(3)이 배치된다. 평탄화층(3)에 의해, 유리하계는 캐리어 기관(1)과 반대 방향을 향해 있는 모듈의 표면이 평활하게 생성될 수 있다. 바람직하게는, 평탄화층(3)은 전기 절연성이고, 더욱 바람직하게는, 평탄화층(3)은 유전체 물질을 함유한다.
- [0076] 바람직하게는, 평탄화층(3)은 실리콘계이다. 특히, 평탄화층(3)은 실리콘을 함유한다. 부가적 또는 대안적으로, 평탄화층(3)은 다른 폴리머 또는 무기 물질을 함유할 수 있다.
- [0077] 평탄화층(3)의 높이는 복사 방출 반도체 소자(2)의 높이를 초과할 수 있다. 특히, 평탄화층(3)은 복사 방출 반도체 소자(2)의 높이를 초과하여 이어질 수 있어서, 상기 평탄화층은 적어도 부분적으로, 캐리어 기관(1)과 반대 방향인 복사 방출 반도체 소자(2)의 표면 상부에 연장된다. 이를 통해, 특히 복사 방출 반도체 소자(2)의 전기 절연성이 개선된다. 이 경우, 평탄화층(3)은 바람직하게는, 복사 방출 반도체 소자(2)로부터 방출된 복사에 대해 적어도 부분적으로 복사 투과성인 물질로 구성된다.
- [0078] 평탄화층(3)은 적어도 하나의 변환 부재(6)를 더 포함할 수 있다. 바람직하게는, 변환 부재(6)는 복사 방출 반도체 소자(2) 중 적어도 하나로부터 방출된 복사를 흡수하고 이러한 복사를 다른 파장 영역의 복사로 변환하여, 모듈로부터 방출된 복사가 혼합 복사로 생성된다.
- [0079] 변환 부재(6)가 목적에 맞게 선택됨으로써, 복사 방출 반도체 소자(2)로부터 방출된 복사의 색 위치가 변경될 수 있다. 이를 통해, 유리하게도, 모듈로부터 방출된 복사의 원하는 색 위치가 얻어질 수 있다. 더욱 바람직하게는, 모듈은 백색의 색 위치 영역에서 복사를 방출한다.
- [0080] 바람직하게는, 복사 방출 반도체 소자들(2)은 프레임(7)에 의해 함께 둘러싸이고, 프레임은 캐리어 기관(1)상에 배치된다.
- [0081] 바람직하게는, 프레임(7)은 세라믹 또는 플라스틱을 함유한다. 도 1의 실시예에서, 프레임(7)을 이용하여 복사 방출 반도체 소자(2) 및 평탄화층(3)은 공간적으로 주변으로부터 분리된다. 유리하게는, 프레임(7)은 복사 방출 반도체 소자(2)를 예를 들면 환경 영향으로부터 보호한다. 환경 영향이란 예를 들면 충격이 있다.
- [0082] 복사 방출 반도체 소자(2)상에, 그리고 평탄화층(3)상에 바람직하게는 적어도 부분적으로 전기 절연층(4)이 배치된다. 전기 절연층(4)은 각각 복사 방출 반도체 소자(2)의 제1접촉면(21)의 영역에서 리세스를 포함한다.
- [0083] 바람직하게는, 전기 절연층(4)은 활성층으로부터 방출된 복사 방출 반도체 소자(2)의 복사에 대해 적어도 부분적으로 복사 투과성이다. 복사 방출 반도체 소자(2)로부터 방출된 복사는 전기 절연층(4)을 통해 아웃커플링될 수 있고, 이때 현저한 광학적 손실을 입지는 않는다.
- [0084] 복사 방출 반도체 소자(2)로부터 방출된 복사가 모듈로부터 아웃커플링되는 것은, 도 1 내지 7의 실시예에서 바람직하게는 캐리어 기관(1)과 반대 방향을 향해 있는 모듈의 측에서 이루어진다.
- [0085] 바람직하게는, 전기 절연층(4)은 필름, 래커 또는 폴리머층이다.
- [0086] 전기 절연층(4)은 평탄화층(3)과 마찬가지로 적어도 하나의 변환 부재를 포함할 수 있다(미도시). 전기 절연층에서 변환 부재는, 바람직하게는 복사 방출 반도체 소자(2)로부터 방출된 복사를 적어도 부분적으로 흡수하고, 다른 파장 영역에서 2차 복사를 방출한다. 이를 통해, 모듈은 혼합 복사를 방출하고, 상기 혼합 복사는 복사 방출 반도체 소자(2)의 1차복사 및 변환 부재의 2차 복사를 포함한다.
- [0087] 변환 부재 또는 변환 부재들이 직접적으로 전기 절연층(4) 및/또는 평탄화층(3)에 통합됨으로써, 유리하게는 다른 부가적 광학층들이 필요하지 않다. 광학층이란 예를 들면 반도체 소자로부터 방출된 복사의 색 위치를 목적에 맞게 변경하거나/변경하고 보정하는 층이다. 따라서, 유리하게는, 반도체 소자(2)로부터 방출된 복사가 반도체 소자(2)에서 거의 변환될 수 있다. 모듈은 콤팩트하게 얻어진다.
- [0088] 전기 절연층(4)은 국부적으로 리세스를 포함한다. 바람직하게는, 각각, 복사 방출 반도체 소자(2)의 제1접촉면(21)의 영역에서 전기 절연층(4)안에 리세스가 형성된다.
- [0089] 바람직하게는, 전기 절연층(4)은 일체형으로 형성된다.
- [0090] 캐리어 기관(1)과 반대 방향을 향해 있는 모듈의 표면상에서, 국부적으로 전기 절연층(4)상에 도전 구조체들이 배치된다(미도시).
- [0091] 도 1의 실시예에서, 모듈은 도전 구조체들이 적층되기 이전의 상태로 도시되어 있다. 실시예(1)의 모듈은 제조 공정 중의 모듈을 나타낸다.

- [0092] 도 1의 실시예에서, 스텐실(5)은 캐리어 기관(1)과 반대 방향을 향해 있는 모듈의 측에 배치된다. 스텐실(5)은 도전 구조체들이 적층되는 제조 단계 중에 사용된다.
- [0093] 스텐실(5)은 도전 구조체들의 구조화를 위해 사용된다. 특히, 스텐실(5)은 바람직하게는 전기 절연층(4)의 리세스의 영역에서 리세스를 포함한다.
- [0094] 바람직하게는, 도전 구조체들은 인쇄 방법을 이용하여 전기 절연층(4) 또는 스텐실(5) 상에 적층된다. 인쇄 방법, 특히 스크린 인쇄 방법 또는 패드 인쇄 방법을 이용하여, 바람직하게는 한점의 도전 구조체, 특히 금속배선층이 복사 방출 반도체 소자(2)의 회로 형성을 위한 목적으로 적층될 수 있다.
- [0095] 바람직하게는, 도전 구조체들의 구조화는 스텐실(5)을 통해 형성되어, 복사 방출 반도체 소자(2)가 도전 구조체들을 이용하여 소정의 방식으로 상호 간에 전기 전도적으로 연결되거나, 캐리어 몸체의 도전로들과 전기 전도적으로 연결된다. 따라서, 도전 구조체들은 적어도, 복사 방출 반도체 소자(2)의 제1접촉면을 다른 복사 방출 반도체 소자(2)의 다른 제1접촉면과 전기적으로 연결하거나, 캐리어 기관(1)의 도전로와 전기적으로 연결한다(미도시).
- [0096] 도전 구조체들의 적층 이후에, 스텐실(5)은 제거된다. 스텐실(5)은 다만 일시적으로 제조 공정 중에 모듈상에 배치된다.
- [0097] 도 2의 실시예에서, 완성된 모듈의 실시예가 도시되어 있으며, 상기 모듈은 도전 구조체들(8)을 포함한다.
- [0098] 도 1에 도시된 실시예와 달리, 도 2의 모듈은, 캐리어 기관(1)상에 배치되어 복사 방출 반도체 소자(2) 및 평탄화층(3)을 둘러싸는 프레임을 포함하지 않는다.
- [0099] 바람직하게는, 복사 방출 반도체 소자(2)는 납땜 또는 전기 전도 접착제를 이용하여 캐리어 기관(1)의 구조화된 도전로상에 고정된다.
- [0100] 도 1의 실시예의 경우와 같이, 전기 절연층(4)은 복사 방출 소자(2) 및 평탄화층(3)상에 적층된다. 전기 절연층(4)은 복사 방출 반도체 소자(2)의 제1접촉면(21)의 영역들에서 리세스를 포함한다. 이러한 리세스는 바람직하게는 레이저 방법 또는 리소그래피 방법을 이용하여 제조된다.
- [0101] 도 1의 실시예와 달리, 도전 구조체들(8)은 예를 들면 젯 인쇄 방법을 이용하여 전기 절연층(4)상에 적층된다. 도전 구조체들(8)의 적층은 바람직하게는 노즐(9)을 이용한다. 노즐(9)은 캐리어 기관(1)과 반대 방향을 향해 있는 모듈의 측에서 도전 구조체들, 바람직하게는 1점의 금속 경로를 설계한다. 특히, 도전 구조체들(8)은 전기 절연층(4)상에 적층되어, 복사 방출 반도체 소자들(2)의 상호간 전기 접촉 또는 캐리어 기관(1)의 도전로와의 전기 접촉이 이루어진다. 특히, 도전 구조체들(8)은 각각 복사 방출 반도체 소자(2)의 제1접촉면(21)의 영역에 위치한다.
- [0102] 복사 방출 반도체 소자(2)는 별도로 접지될 수 있다. 또는, 복사 방출 반도체 소자(2)는 상호간에 전기 전도적으로 연결될 수 있다.
- [0103] 도 3의 실시예는 도 2의 실시예에 비해, 캐리어 기관(1)이 연성 기관이라는 점에서 상이하다. 특히, 캐리어 기관(1)에서 복사 방출 반도체 소자(2)가 배치된 표면은 평활하지 않다. 캐리어 기관(1)은 예를 들면 아치 곡면을 포함할 수 있다. 특히, 캐리어 기관(1)의 표면은 복사 방출 반도체 소자(2)의 실장이 가능한 경우에 한하여 다른 형상도 가질 수 있다.
- [0104] 특히, 모듈은 도 3의 실시예에서 회전 가능하게 배치될 수 있다. 이를 통해, 유리하게는 예를 들면 모듈의 제조가 간단해진다. 노즐을 이용하여 도전 구조체들을 설계하는 방법 단계동안 모듈은 예를 들면 원하는 도전 구조체들의 구조화에 상응하여 움직이고 예를 들면 회전할 수 있다.
- [0105] 도 4의 실시예에서, 광전 모듈의 일부가 도시되어 있다. 특히, 모듈의 복사 방출 반도체 소자(2)만이 도시되어 있다. 모듈의 다른 복사 방출 반도체 소자들은 개관상의 이유로 도시되지 않았다.
- [0106] 캐리어 기관(1)상에서 복사 방출 반도체 소자(2)는 바람직하게는 접착성 층을 이용하여 접착되거나, 땀납을 이용하여 납땜된다. 도 4에 도시된 바와 같이, 바람직하게는 복사 방출 반도체 소자(2)상에 그리고 캐리어 기관(1)상에 전기 절연층(4)이 배치된다. 전기 절연층(4)은 예를 들면 라미네이팅된 필름 또는 유리를 함유한 층이다.
- [0107] 전기 절연층(4)은 복사 방출 반도체 소자(2)의 제1접촉면(21)의 영역에서 리세스를 포함한다. 바람직하게는,

전기 절연층(4)은 유전체층이다.

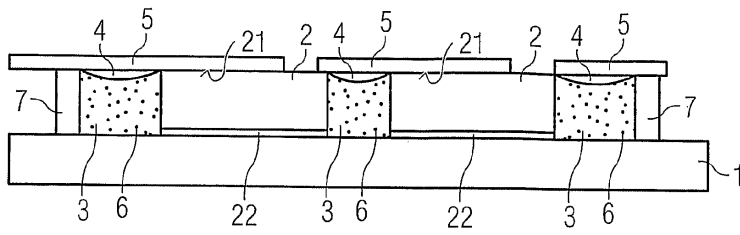
- [0108] 바람직하게는, 모듈의 제조 공정 동안 전기 절연층(4)상에 도전 구조체, 더욱 바람직하게는 금속층이 기상 증착을 이용하여 전면으로(whole surface) 증착된다(미도시). 바람직하게는, 전면적인 도전 구조체는 물리 기상 증착 또는 화학 기상 증착을 이용하여 증착된다. 이어서, 전면으로 형성된 도전 구조체는 예를 들면 포토리소그래피 및 식각을 이용하여 복사 방출 소자(2)의 원하는 회로에 상응하여 구조화된다. 특히, 전면적 도전 구조체는 바람직하게는 복사 방출 반도체 소자가 상호간 전기 전도적으로 연결되거나, 복사 방출 반도체 소자(2)가 캐리어 기관(1)의 도전로와 전기 전도적으로 연결되도록 구조화된다.
- [0109] 바람직하게는, 공정을 더욱 간단하고 개선된 방식으로 실시하기 위해, 전기 절연층, 특히 유전체층이 도전 구조체들의 증착 이전에 평탄화되고, 예를 들면 SOG 방법을 이용하여 평탄화된다.
- [0110] 도 5의 실시예에서, 다른 광전 모듈의 일부가 도시되어 있다. 이 경우에도, 개관상의 이유로 복사 방출 반도체 소자(2)만이 도시되어 있다.
- [0111] 도 4에 도시된 실시예와 달리, 도전 구조체(8)는 이방성층(8a, 8b)으로 형성된다. 바람직하게는, 이방성층(8a, 8b)은, 라미네이팅되는 것이 바람직한 이방성 필름이다.
- [0112] 바람직하게는, 이방성층은 2개의 부분 영역들(8a, 8b)을 포함한다. 부분 영역들 중 하나(8a)는 전도성으로 형성되는 것이 바람직하다. 그에 반해, 다른 부분 영역(8b)은 전기 절연성이다.
- [0113] 이방성층의 영역(8a)에서 전도도의 형성은 바람직하게는 국부적으로 인가된 압력 또는 조사에 의해 이루어진다. 이를 통해, 유리하게는 복사 방출 반도체 소자(2)의 전기적 연결이 제1접촉면(21)의 영역에서 보장된다.
- [0114] 바람직하게는, 이방성층(8a, 8b)은 제2부분 영역(8b)에서 복사 방출 반도체 소자(2)로부터 방출된 복사에 대해 적어도 부분적으로 복사 투과성이다. 또는, 상기 제2부분 영역(8b)에서 이방성층(8a, 8b)은 라미네이팅된 이후 선택적으로 제거될 수 있다. 이 경우, 이방성층(8a, 8b)은 복사 투과성이 아니어야 한다.
- [0115] 도 6에 도시된 광전 모듈의 실시예는 복수 개의 복사 방출 반도체 소자들(2)을 포함하고, 상기 반도체 소자들은 뿔납 또는 접착성층(10)을 이용하여 캐리어 기관(1)상에 고정된다. 바람직하게는, 복사 방출 반도체 소자(2)의 제2접촉면(22)은 캐리어 기관(1)상에 배치된 도전로와 전기 접촉한다. 바람직하게는, 복사 방출 반도체 소자(2)의 도전로는 서로 전기적으로 절연되어 배치된다.
- [0116] 선행한 실시예에 도시된 모듈과 달리, 도 6의 실시예에서는 구조화된 도체판 및 도전 구조체들(8)에 의한 전기 절연층(4)이 상기 도체판으로부터 돌출된 전기 전도웹, 예를 들면 금속웹으로 형성된다.
- [0117] 도체판은 특히 전기 절연 물질을 포함하고, 상기 전기 절연 물질안에 전기 전도적 도전로가 포함되어 있다. 더욱 바람직하게는, 도체판의 전기 절연 물질은 복사 방출 반도체 소자(2)로부터 방출된 복사에 대해 적어도 부분적으로 복사 투과성이다. 도체판의 전기 절연 물질은 복사 방출 반도체 소자(2)로부터 방출된 복사를 변환하기 위해 적어도 하나의 변환 부재를 더 포함할 수 있다.
- [0118] 도체판의 전기 절연 물질에 포함된 도전로는 바람직하게는 적어도 부분적으로 금속웹(8)과 전기 전도적으로 연결된다. 또한, 금속웹(8)은, 각각, 바람직하게는 복사 방출 반도체 소자(2)의 제1접촉면(21)과 전기 전도적으로 연결된다. 이를 위해, 도체판(4)은 복사 방출 반도체 소자(2)의 제1접촉면(21)의 영역에서 리세스를 각각 포함한다.
- [0119] 웹(8) 및 도체판(4)의 도전로를 경유하여, 복사 방출 반도체 소자(2)는 각각 전기적으로 접촉된다. 이때, 복사 방출 반도체 소자(2)는 전기 전도적으로 상호간 연결되거나, 전기 전도적으로 각각 캐리어 기관(1)의 도전로와 연결될 수 있다.
- [0120] 바람직하게는, 금속웹(8)은 상기 금속웹이 도체판의 접촉 지점으로부터 복사 방출 반도체 소자(2)의 방향으로 굴곡지도록 형성된다.
- [0121] 이러한 실시예에서, 복수 개의 도체판들이 포개어져 배치될 수 있어서, 다접의 배열 및 그로 인한 다접의 회로면이 모듈내에 형성된다(미도시).
- [0122] 금속웹(8)은 예를 들면 각각 스탬핑 웨지 공정을 이용하여 복사 방출 반도체 소자(2)의 제1접촉면(21)과 전기적 및 기계적으로 연결될 수 있다.
- [0123] 도 7a, 7b에서 각각 광전 모듈의 개략적 일부가 도시되어 있다. 도 7a는 모듈의 일부를 횡단면도로 도시한다.

도 7b는 도 7a의 일부분을 평면도로 도시한다.

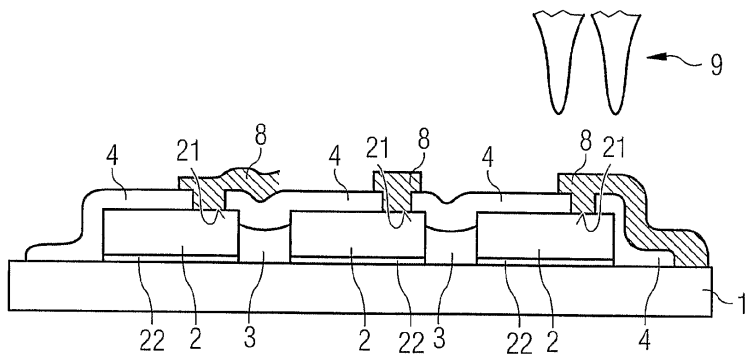
- [0124] 도 7a에는 복사 방출 반도체 소자(2)가 도시되어 있다. 광전 모듈은 바람직하게는 예를 들면 도 7a에 도시된 바와 같은 복수 개의 복사 방출 반도체 소자들(2)로 구성되고, 이때 복사 방출 반도체 소자(2)는 바람직하게는 캐리어 기판(1)상에 배치된다.
- [0125] 도 1 내지 6의 실시예와 달리, 도 7a의 복사 방출 반도체 소자(2)는 제1접촉면(21)을 포함하고, 상기 제1접촉면은 전기 절연층(4)상에 이어진다. 전기 절연층(4)은 각각 국부적으로 복사 방출 반도체 소자(2)의 측면에서 각각의 복사 방출 반도체 소자(2)의 둘레에서 이어진다. 바람직하게는, 전기 절연층(4)은 복사 방출 반도체 소자(2)의 측면에서 반도체 소자(2)의 활성층(2a)을 경유하여 이어진다.
- [0126] 바람직하게는, 제1접촉면(21)도 마찬가지로 반도체 소자(2)의 측면에서 이어진다. 특히, 제1접촉면(21)은 전기 절연층(4)상에 이어진다. 캐리어 기판과 반대 방향을 향해 있는 복사 방출 반도체 소자(2)의 표면은 바람직하게는 제1접촉면(21)을 포함하지 않는다.
- [0127] 반도체 소자(2)의 측면을 따라 제1접촉층(21)이 이어짐으로써, 복사 방출 반도체 소자(2)의 전원 공급이 균일하게 보장된다.
- [0128] 바람직하게는, 제1접촉층(21)의 영역에 전기적 공급부(12)가 연결된다. 반도체 소자(2)의 측면을 따라 제1접촉층(21)이 이어짐으로써, 제1접촉층(21)의 임의의 영역들에서 반도체 소자(2)의 전기적 회로를 위한 전기적 공급부들(12)이 이어질 수 있다. 모듈의 반도체 소자들은 공급부들(12)을 경유하여 상호간에 전기 접속될 수 있다. 또는, 반도체 소자들은 각각 별도로 전기적으로 연결될 수 있다.
- [0129] 도 7b에는 도 7a의 반도체 소자의 접촉 방식에 대한 평면도가 도시되어 있다. 제1접촉면(21)은 반도체 소자(2)의 복사 아웃커플링면의 측에 배치된다. 바람직하게는, 제1접촉층(21)은 프레임형으로 형성된다. 특히, 제1접촉층(21)은 닫힌 경로를 형성한다. 제1접촉층(21)에서 국부적으로, 전기적 공급부(12)가 배치되며, 상기 전기적 공급부는 반도체 소자(2)의 회로를 위해 역할한다.
- [0130] 바람직하게는, 도 7a, 7b의 실시예에서 복사 방출 반도체 소자(2)상에 전류 분포층(13)이 배치된다. 특히, 전류 분포층(13)은 반도체 소자(2)로부터 방출된 복사에 대해 적어도 부분적으로 복사 투과성이다. 예를 들면, 전류 분포층(13)은 ITO층 또는 ZnO층이다.
- [0131] 바람직하게는, 제1접촉층(21)은 금속배선이다. 바람직하게는, 반도체 소자(2)의 복사 아웃커플링면은 금속배선을 포함하지 않는다. 바람직하게는, 금속배선은 반도체 소자(2)를 중심으로 그 둘레에 이어짐으로써, 예를 들면 종래에 사용되는 본딩 패드를 이용한 경우보다 더 균일한 전원 공급이 보장된다.
- [0132] 도 7c에는 도 7a의 복수 개의 복사 방출 반도체 소자(2)를 포함한 모듈의 평면도가 도시되어 있다. 이 경우, 모듈은 4개의 복사 방출 반도체 소자들(2)을 포함한다. 그러나, 각각의 사용 범위 및 모듈의 사용 목적에 따라 다른 개수의 반도체 소자(2)도 가능하다.
- [0133] 반도체 소자(2)의 제1접촉면(21)이 측면에 배치되어 전기적으로 이어짐으로써, 반도체 소자(2)의 복합 회로가 구현될 수 있다. 이를 통해, 유리하게도, 캐리어 기판(1)상에 반도체 소자들(2)이 공간 절약적으로 배치될 수 있다.
- [0134] 특히, 반도체 소자들(2)은 개별적으로 캐리어 기판(1)상에 실장되고, 서로가 각각 전기 전도적으로 연결될 수 있다. 이 경우, 캐리어 기판(1)은 반도체 소자(2)를 위한 실장층에서 각각 서로 전기적으로 절연된 도전로들을 포함하고, 상기 도전로들상에 각각 하나의 반도체 소자가 기계적 및 전기적으로 연결되어 있다.
- [0135] 또는, 반도체 소자들(2)은 상호간에 전기적으로 접속될 수 있다. 이때, 바람직하게는, 캐리어 기판(1) 자체는 전기 전도성으로 형성되어, 반도체 소자들(2)이 공통의 전기 전위에 놓인다. 또는, 캐리어 기판(1)상에 도전로가 배치될 수 있고, 상기 도전로상에 반도체 소자들(2)이 공통으로 배치되어 있다. 반도체 소자들(2)의 전기적 공급부(12)는 바람직하게는 다른 전기적 연결부로 이어진다(미도시).
- [0136] 본 발명은 실시예에 의거한 설명에 의하여 이러한 실시예에 한정되지 않는다. 오히려 본 발명은 각각의 새로운 특징 및 특징들의 각 조합을 포함하고, 이러한 점은 특히, 비록 이러한 특징 또는 이러한 조합이 그 자체로 명백하게 특허청구범위 또는 실시예에 제공되지 않더라도 특허청구범위에서의 특징들의 각 조합을 포괄한다.

도면

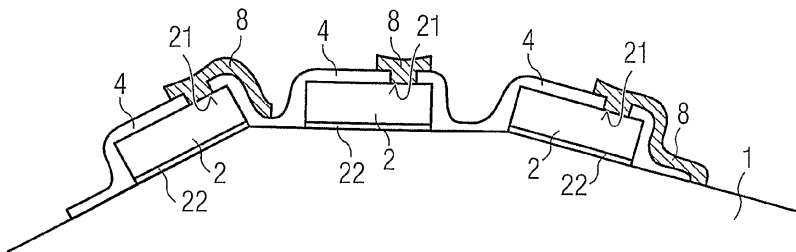
도면1



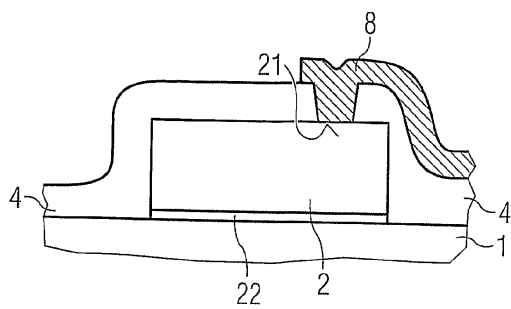
도면2



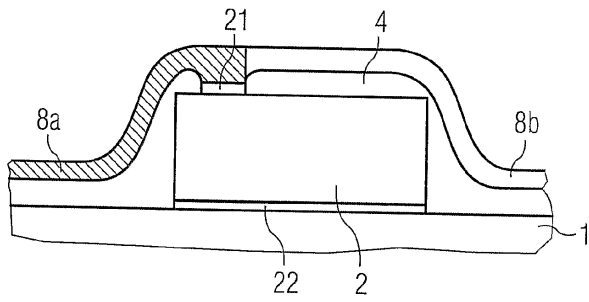
도면3



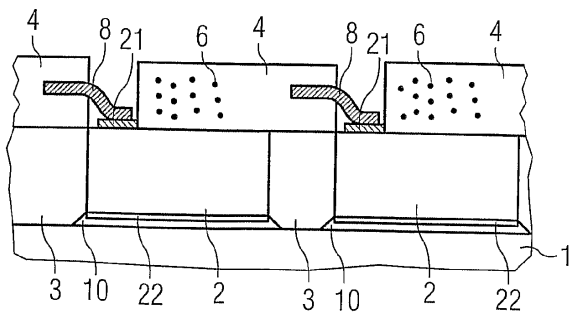
도면4



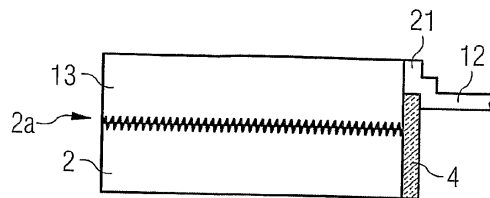
도면5



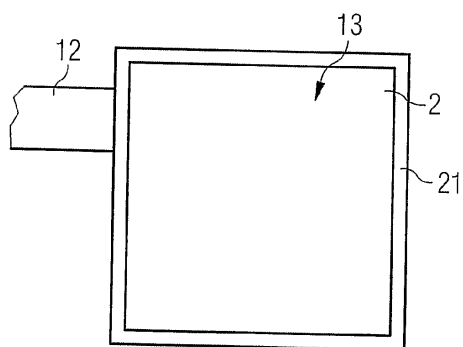
도면6



도면7a



도면7b



도면7c

